

# NdGaO<sub>3</sub>(ネオジウムガレート)基板

当社ではエピタキシャル成長に最適なNdGaO<sub>3</sub>基板を提供しております。  
ぜひとも皆様のご研究にお役立てください。

## 【特長】

- ・超伝導薄膜との格子整合性が良好
- ・高品質
- ・結晶成長から基板加工まで一貫生産

## 【諸性質】

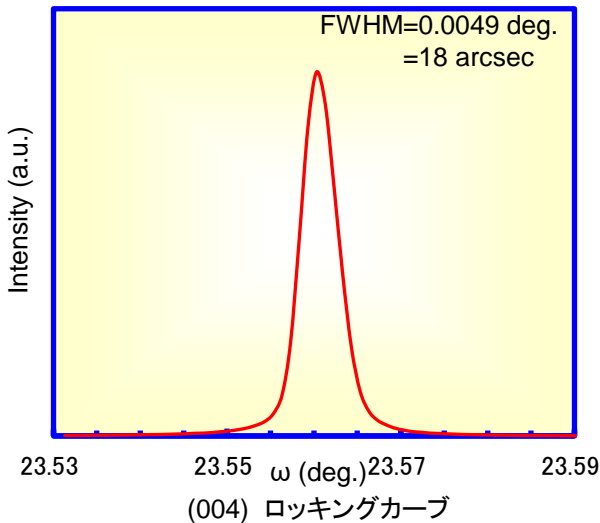
結晶系	直方晶 (斜方晶)
結晶構造	ペロブスカイト型構造
格子定数	a = 0.5431 nm b = 0.5499 nm c = 0.7710 nm
融点	1650 °C
密度	7.56 g/cm <sup>3</sup>
誘電率	20~25 (27°C, 1MHz)
熱膨張係数	10 × 10 <sup>-6</sup> /°C



## 【標準仕様】

面方位	(100), (001), (110), (011) 公差: ±0.5°
サイズ	10 × 10 × 0.5mm 15 × 15 × 0.5mm 外形公差: ±0.1mm, 厚み公差: ±0.05mm
研磨	片面 / 両面
表面粗さ	Ra ≤ 1.0nm, Rmax ≤ 5.0nm
平坦度	10 × 10 × 0.5mm: ≤ λ 15 × 15 × 0.5mm: ≤ 1.5λ (λ = 632.8nm)

※お客様のご要望により特殊仕様も承ります。



グラフや表の値は代表値であり、保証値ではありません。

## 仕様

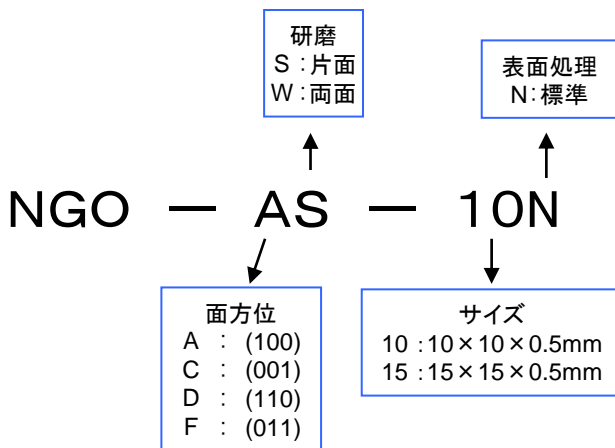
サイズ	研磨	面方位			
		(100)	(001)	(110)	(011)
10x10x0.5mm	片面	○	○	○	△
〃	両面	△	△	△	△
15x15x0.5mm	片面	△	△	△	△
〃	両面	△	△	△	△

○:標準品 △:受注生産品

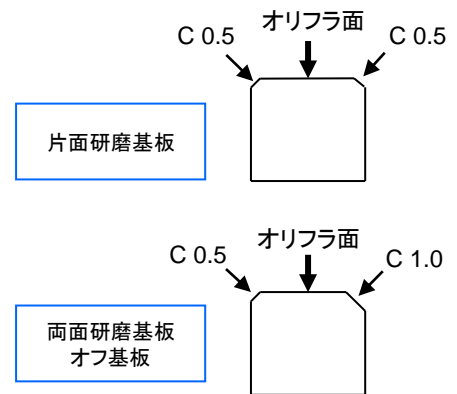
サイズ違い、オフ基板についても承ります。お問い合わせ下さい。

\* 受注生産品および特殊仕様品は、5枚から承ります(在庫状況により柔軟に対応いたします)。

## 型番



## オリフラ



基板面方位	オリフラ
(100)	(001)
(001)	(100)
(110)	(001)
(011)	(100)

<外観検査基準について>

- ・外周から0.2mm以下、厚みの1/2以下のカケは不問とさせていただきます。
- ・片面研磨品の裏面キズ、シミは不問とさせていただきます。

お問い合わせは  
**SHINKOSHA Co., Ltd.**

**株式会社 信光社** 営業部

〒247-0007神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷2-4-1

TEL: 045-892-4393, FAX: 045-892-2986

E-mail: sales@shinkosha.com

URL: <http://www.shinkosha.com/>